

طراحی و شبیهسازی یک جمع کننده کامل دودویی مبتنی بر حلقههای کوانتومی

امير تقوى مطلق و حجت الله خواجه صالحاني *

گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده: : در این مقاله، با استفاده از هشت حلقه کوانتومی که از هر یک حلقهها شار مغناطیسی $\frac{\mathbf{y}}{2} = \boldsymbol{\varphi}$ عبور کرده است یک مدار جمع کننده کامل دودویی طراحی شده است. حلقههای کوانتومی به دو گروه چهارتایی تقسیم شدهاند که به صورت موازی به یکدیگر متصل شده اند. این آرایش از دو طرف بطور متقارن به الکترودهای نیمه بی نهایت متصل شدهاند که به صورت موازی به عنوان ورودیهای جمع کننده کامل دودویی طراحی شده است. حلقههای کوانتومی به دو گروه چهارتایی تقسیم شدهاند که به صورت موازی به یکدیگر متصل شده اند. این آرایش از دو طرف بطور متقارن به الکترودهای نیمه بی نهایت متصل شدهاند و سه ولتاژ گیت نیز به عنوان ورودیهای جمع کننده کامل به حلقه ها اعمال شده است. هامیلتونی سیستم با استفاده از روش بستگی قوی تقریب زده شد و جریان عبوری از آن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی محاسبه شده است. مشخصههای هدایت الکتریکی-انرژی و جریان-ولتاژ برای مقادیر متفاوت ولتاژهای گیت بدست آمده است. نتایج نشان میدهند این مدار کوانتومی همانند مدار یک

واژگان کلیدی: ترابرد کوانتومی، حلقه کوانتومی، جمع کننده کامل، تابع گرین.

hksalehani@damavandiau.ac.ir

۱– مقدمه

در سالهای اخیر و به واسطه پیشرفت های حاصل شده در تکنولوژی، امکان ساخت نانو ساختارهایی وجود دارد که می توانند به عنوان اجزای اصلی در آینده صنعت الکترونیک باشند. مطالعه ترابرد الکترونی در این نانوساختارها همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و پس از اولین مطالعه انجام شده توسط آویرام و راتنر^{([۱}]، به تازگی نیز مطالعات تئوری و تجربی متفاوتی درباره ترابرد الکترون در سیستمهای متفاوت انجام شده است[۲–۸].

حلقههای کوانتومی از جمله نانوساختارهایی هستند که اندازه آنها از مرتبه طول فاز همدوسی^۲ الکترونها می باشد و به واسطه ساختار هندسی خاص و منحصر به فردشان پدیده های کوانتومی همچون نوسان آهارانوف-بوهم^۳ [۹] و جریان ماندگار^۴ [۱۰] را نمایش میدهند. بطور کلی حلقههای کوانتومی توسط دو مدل شبیه سازی می شوند که عبارتند از: مدل گسسته و مدل پیوسته. در مدل گسسته حلقهها از M نقطه شبکه با N الکترون تشکیل شده است که الکترونها میتوانند از یک نقطه شبکه به نقطه

تاریخ دریافت : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

² Coherence phase

³ Aharonov - Bohm

⁴ Persistent current

تاریخ پذیرش : ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

دیگر بپرند. مطالعه ترابرد الکترون در حلقه های کوانتومی و استفاده از تداخل های سازنده و ویرانگر امواج الکترونی در این ساختارهای حلقوی شکل، امکان طراحی و شبیهسازی انواع گیتهای منطقی کوانتومی را بوجود آورده است[۱۱–۲۲]. در مراجع [۱۱–۱۹] ترابرد الکترون در سیستم هایی شامل یک یا چند حلقه کوانتومی که از هر حلقه شار مغناطیسی ثابتی عبور میکند و از دو طرف به الکترودهای چشمه ^۵و درآشامنده ²متصل شده اند مورد بررسی قرار گرفته شده است. با اعمال ولتاژهای گیت به نقاطی از حلقه ها به عنوان ورودی سیستم، انواع گیتهای منطقی کوانتومی طراحی شده است. مایتی^۷ با استفاده از جفت حلقه $arphi_0$ کوانتومی که از هر حلقه شار مغناطیسی $arphi_0/2=arphi_0$ (که كوانتوم شار است) عبور مىكند، يك گيت منطقى AND طراحى و شبیه سازی کرده است [۱۱] و در این آرایش حلقهها به صورت سری به یکدیگر متصل شدند و از دو سمت به الکترود فلزی نيمه بي نهايت متصل شده و دو ولتاژ گيت به بازوي زيرين حلقهها اعمال می شود. این ولتاژهای ورودی نقش ورودی های گیت AND را بازی می کنند. نتایج بدست آمده براساس نمودارهای هدایت _ انرژی و جریان _ ولتاژ برای دو حالت جفت شدگی قوی و ضعیف[^] نشان میدهد که ساختار در نظر گرفته شده با در نظر گرفتن ولتاژهای گیت اعمالی به عنوان ورودی و جریان عبوری از حلقه به عنوان خروجی همانند یک گیت AND رفتار مي كند. او با تغيير تعداد حلقه ها، آرايش اتصال آنها و همچنین، تغییر نقاط اعمال ولتاژ گیت، سایر گیتهای منطقی همچون NOR ،NAND ،XNOR ،XOR ،OR و NOR ،I طراحي كرد [١٢-١٧].

خانزادی و خواجه صالحانی با استفاده از سه حلقه کوانتومی و استفاده از مدل بستگی قوی[°] و همچنین روش تابع گرین به طراحی و شبیه سازی انواع گیت های منطقی NN، AND، مراحی و شبیه سازی انواع گیت های منطقی NOR پرداختند [۱۸]. در این مقاله نیز ولتاژهای گیت اعمالی به نقاط متفاوت به عنوان

ورودی گیتها و جریان عبوری نیز به عنوان خروجی گیت در نظر گرفته شد.

در مرجع [۱۹]، ترابرد الکترون در حلقه کوانتومی دوگانه هم مرکز مورد بررسی قرار گرفته شد. در این ساختار حلقه بیرونی به الکترودها متصل است و ارتباط آن با حلقه داخلی از طریق جفت شدگی تونلی است. با مطالعه نوسانهای آهارانوف–بوهم در منحنی هدایت الکتریکی، تاثیر جفت شدگی بین حلقهها، دما و برهمکنش الکترونها بر منحنی هدایت الکتریکی و جریان عبوری از حلقه بررسی و با اعمال شارمغناطیسی ثابت عبوری از حلقه و ولتاژ گیت نامتقارن به نقاطی از حلقه بیرونی یک گیت نانومقیاس XOR طراحی شد.

با بررسی ترابرد اسپینی در حلقه های کوانتومی و محاسبه قطبش اسپینی در حضور برهمکنش اسپین-مدار راشبا، انواع گیتهای منطقى NOT ،OR ،AND و NAND طراحى شد [٢٥-٢١]. در مرجع [۲۲]، قطبش اسپینی و انتشار زمانی هارمونیکهای مربوط به تابش انجام شده در حلقه ای که تحت تاثیر میدان مغناطیسی متغییر قرار دارد مورد مطالعه قرار گرفته شده است. با اختصاص ۰ و ۱ به شدتهای بالا و پایین تابشهای گسیل شده از حلقه کوانتومی به عنوان خروجی یک گیت منطقی NOT طراحی شد [۲۲]. با بررسی منابع و مطالعات انجام شده مشاهده می شود هر چند از نانوساختارهایی همچون حلقه های کوانتومی در طراحی انواع گیتهای کوانتومی استفاده شده است اما تاکنون با استفاده از این نانوساختارها یک مدار جمع کننده کامل طراحی نشده است. در این مقاله یک جمع کننده کامل دودویی شامل هشت حلقه کوانتومی که از هر حلقه شار مغناطیسی ثابت می عبور می کند، شبیه سازی می شود. کل سیستم $\varphi = \varphi_0/2$ متشکل از هشت حلقه کوانتومی به دو بخش مجزا (حاصل جمع ورودی ها و مقدار نقلی خروجی) تقسیم شده و در هر بخش دو الكترود نيمه بي نهايت (چشمه _ درآشامنده) بصورت متقارن به دو طرف ساختار كوانتومي متصل شده اند. همچنين ولتاژهاي گیت اعمالی V_c ، V_b ، V_a نقش ورودی های سیستم را دارند که $V_{\rm s}$ مقدار نقلی ورودی جمع کننده کامل است و $V_{\rm s}$ نیز یک ولتاژ ثابت است که همواره به حلقه اعمال شده و از نظر اندازه با ولتاژ ورودی ها یکسان است. برای مدلسازی از مدل

⁵ Source

⁶ Drain

⁷ Maiti

⁸ Strong and weak coupling

⁹ Tight binding model

بستگی قوی و برای انجام محاسبات از روش تابع گرین ^{۱۰} استفاده شده است. با محاسبه منحنی مشخصه های جریان-ولتاژ و همچنین، هدایت الکتریکی به صورت تابعی از انرژی نشان داده می شود به ازای ورودیهای مناسب ساختار کوانتومی پیشنهاد شده همانند یک جمع کننده کامل دودویی رفتار می کند.

> ۲– مدل نظری جمع کننده کامل مبتنی بر حلقه های کوانتومی

شکل (۱) طرحی از یک جمع کننده کامل دودویی طراحی شده با استفاده از حلقه های کوانتومی را نشان میدهد. طبق روابط بولی [23] در یک جمع کننده کامل حاصل جمع ورودی ها و مقدار نقلی خروجی برابر است با:

$$Sum = A \oplus B \oplus C = A(BC + B'C') + A'(B'C + BC')$$
(1)

Carry out = AB + AC + BC = A(B + C) + BC

(۲)

رابطه (۱) حاصل جمع ورودی ها (A و B و C) و رابطه (۲) مقدار نقلی را نشان میدهد. برای اینکه ساختار کوانتومی مناسب با استفاده از روابط (۱) و (۲) شبیه سازی شود، این روابط به گیت-های پایه بسط داده شدهاند. به عبارت دیگر هر کدام از بلوک های قرمز رنگ بیانگر هر یک از زوج حلقه های کوانتومی است که به صورت سری به هم دیگر جفت شدهاند (شکل (۱)). وجود ولتاژهای ورودی بر نقاط متفاوت شبکه، وجه تمایز این جفت حلقهها از همدیگر هستند و روابط مورد نظر را پیاده سازی می-کنند.

برای محاسبه هدایت الکتریکی (g) در حلقههای کوانتومی از فرمول هدایت لاندرو[۲۴] استفاده شده که در دمای پایین و ولتاژ بایاس بصورت زیر خواهد بود:

$$g = \frac{2e^2}{h}T$$

$$T = Tr[\Gamma_S G_R^r \Gamma_D G_R^a]$$
(*)

که $G_R^r e G_R^r e G_R^r$ به ترتیب تابع گرین تاخیری و پیشرفته حلقههاست و تحت تاثیر جفت شدگی چشمه و درآشامنده است. همچنین، $\Gamma_5 e \sigma_1^r$ ، توابع انتشار هستند و به ترتیب مشخصه جفت شدگی سیستم با چشمه و درآشامنده هستند. برای یک سیستم کامل شامل حلقههای کوانتومی، چشمه و درآشامنده تابع گرین به صورت زیر تعریف می شود:

$$G = (E - H)^{-1} \tag{(a)}$$

که در آن E انرژی الکترونهای تزریق شده از چشمه است.



¹¹ Green function

¹⁰ Green function

شکل ۱: مدار یک جمع کننده کامل متشکل از هشت حلقه کوانتومی که از دو بخش (Sum) و (Surt Carry) تشکیل شده و هر بخش بصورت متقارن به دو (Sum زمیمه بی نهایت (چشمه _ درآشامنده) متصل شده است. ولتاژ های متغیر V_a و V_b و V_c ورودی های سیستم می باشند و بر نقاط معینی از شبکه اعمال شده اند (V_c مقدار نقلی ورودی در نظر گرفته شده). همچنین V_c ولتاژ ثابت است و نقش NOT منطقی را ایفا می کند.

در واقع برای محاسبه تابع گرین نیاز به وارون ماتریس بی نهایت کل سیستم، شامل حلقههای کوانتومی و دو الکترود نیمه بی نهایت (چشمه و درآشامنده) است. اما برای اینکه بتوان سیستم را بصورت محدود مورد بررسی قرار داد، برای هر قسمت یک زیر ماتریس متناسب با خصوصیات آن بخش در نظر گرفته شده است. از این رو تابع گرین برای سیستم شامل حلقههای کوانتومی بصورت زیر نوشته می شود:

$$G_R = (E - H_R - \Sigma_S - \Sigma_D)^{-1}$$
(\mathcal{F})

که پارامترهای \mathbf{Z}_{e} و \mathbf{Z}_{D} نشان دهنده تابع خود انرژی^{^{۱۲}} هستند و ناشی از جفت شدگی حلقهها و چشمه و درآشامنده می باشند و کلیه اطلاعات مربوط به جفت شدگی در آنها وجود دارد. $\mathbf{H}_{\mathbf{R}}$ هامیلتونی حلقهها در غیاب برهمکنش الکترونهاست و در مدل بستگی قوی به صورت زیر تقریب زده می شود:

$$H_{R} = \sum_{i} (\epsilon_{i} + V_{a}\delta_{ia} + V_{b}\delta_{ib} + V_{c}\delta_{ic} + V_{s}\delta_{is})c_{i}^{\dagger}c_{i} + \sum_{ij} (c_{i}^{\dagger}c_{j}e^{i\Theta} + c_{j}^{\dagger}c_{i}e^{-i\Theta})$$
(Y)

مقاله در دمای صفر درجه فرض شده است. (نتایج و محاسبات در دماهای پایین و نزدیک به صرف نیز معتبر است.) لازم به ذکر است برای سادگی در محاسبات مقادیر c=e=h=1 در نظر گرفته شده است.

۳- نتایج و بحث

انرژی نقاط شبکه حلقه کوانتومی برابر با صفر در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر $\boldsymbol{\epsilon}_i = \boldsymbol{0}$ ولی در نقاط c ، b ، a و s به V_s و V_c ، V_b ، V_a دليل اعمال مقادير ولتاژ ها به ترتيب برابر در نظر گرفته می شود. طبق مبنای دودویی، ورودی ها می تواند برابر با مقدار کم ارزش (٠) یا مقدار پرارزش (۱) باشند. در $V_c = V_b = V_a = 2V$ محاسبات، ورودیهای سیستم برابر با برابر مقدار پر ارزش یا یک منطقی و $V_c = V_b = V_a = 0$ برابر مقدار کم ارزش یا صفر منطقی در نظر گرفته می شود. V_s بطور ثابت برابر با ۲ ولت است. شدت جهش بین نزدیکترین همسایه (t') ها در حلقه های کوانتومی (t) برابر با r و در الکترود ها (\dot{c}) و ۰ به ترتیب برابر با ۰ و ۴ ، و همچنین انرژی فرمی (E_f) مساوی در نظر گرفته شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این مقاله بر $(\tau_{S(D)} \sim t)$ اساس شدت جفت شدگی قوی یعنی حالتی که $(\tau_{S(D)} \sim t)$ محاسبه می شود، که مقدار جفت شدگی بین چشمه و در آشامنده با حلقهها برابر $\tau_{\rm S} = \tau_{\rm D} = 2.5$ در نظر گرفته می شود. مقدار شار عبوری از هر حلقه نیز برابر طبق رابطه (۸) به ازای <mark>n = 0</mark> برابر با $rac{arphi}{2}=rac{arphi}{2}$ در نظر گرفته شده است.

بدلیل پهنای حلقههای کوانتومی، نمیتوان بطور دقیق مرزی برای شاری که از مرکز حلقه عبور میکند تعیین کرد. تقریب دیوار پتانسیل بینهایت نیز تقریب ایده آلی است و بنابراین احتمال حضور ذره حتی در نزدیکی مرکز حلقه وجود دارد. این عوامل سبب شده که از مفهوم لوله شار بینهایت نازکی که از مرکز حلقه عبور میکند، برای بررسی کمیات وابسته به شار استفاده گردد. در نمونه های تجربی حلقه های کوانتومی قطری در محدوده ۴۰۰ تا مغناطیسی بزرگی برای ایجاد شار مغناطیسی کوانتومی لازم مست. برای رفع این مشکل، هد^{۳۲} و همکارانش با مطالعات تجربی بر این نوع از حلقهها، ساختارهای نانومقیاسی را پیشنهاد

¹² Self energy

دادند که در شدت میدانهای مغناطیسی متوسط نیز خاصیت تداخل سنجی آهارانوف-بوهم را داشته باشد [۲۳–۲۶].

شکل(۲)، نمودارهای هدایت الکتریکی بر حسب انرژی الکترون را برای حاصل جمع و مقدار نقلی مربوط به ورودیهای جمع کننده کامل نشان داده در شکل (۱) برای حالتی که تمامی ورودیها (Vc ، Vb ، Va) برابر صفر منطقی است نشان میدهد. مشاهده می شود هدایت الکتریکی نیز برابر با صفر است. در نتیجه انتظار می رود، جریانهای خروجی جمع کننده نیز برابر صفر باشند. مطابق شکل (۳) اگر یکی از ورودیهای سیستم برابر یک منطقی باشد، آنگاه در نمودار هدایت الکتریکی برای حاصل جمع ورودیها (Sum) قلههایی در منحنی هدایت الکتریکی در انرژی های معین دیده می شود اما نمودار هدایت الکتریکی به ازای مقدار نقلی جمع کننده (Carry out) همچنان صفر است. در حالتی که دو تا از ورودی های سیستم برابر یک منطقی باشند (شکل (۴))، آنگاه نمودار هدایت الکتریکی برای جمع ورودیها (Sum) برابر با صفر و نمودار هدایت الکتریکی مربوط به مقدار نقلی (Carry out) دارای قله هایی در انرژیهای مشخص است. طبق شکل (۵) اگر تمامی ورودیها برابر یک منطقی باشند، آنگاه نمودارهای هدایت الکتریکی برای حاصل جمع ورودیها (Sum) و مقدار نقلی (Carry out) دارای قلههایی هستند که منجر به جریان خروجی غير صفر مي شوند.

درواقع تمامی قلههای تشدید هدایت الکتریکی با حالت های انرژی سیستم مرتبط است و بیانگر طیف هدایت الکترونی حلقه-های کوانتومی است. همچنین، دامنه احتمال عبور الکترون از چشمه به درآشامنده، به تداخل کوانتومی امواج الکترونی در دو بازوی بالایی و پایینی حلقه بستگی دارد. چون طول دو بازوی بالایی و پایینی حلقه کوانتومی با یکدیگر برابرند، اگر حلقهها بصورت متقارن به چشمه ودرآشامنده متصل شده باشند و تحت شار مغناطیسی φ قرار بگیرند و هیچ ولتاژی به نقاط شبکه اعمال نشود، دامنه احتمال عبور الکترون از حلقه برابر صفر خواهد بود (T=0). زیرا تداخل کوانتومی موجهای بازوی بالایی و بازوی پایینی حلقه کوانتومی ویرانگر هستند. بنابراین، هنگامی که ورودیهای سیستم مورد نظر برابر صفر باشند، احتمال انتقال الکترون امکان پذیر نیست و در نتیجه جریانی در درآشامنده پدید نخواهد آمد. از سوی دیگر، وجود ولتاژ ثابت v_s در بعضی از

حلقهها باعث شکل گیری حالت NOT منطقی[۱۷] برای ورودی متناظر با آن در بازوی مقابل می شود.



شکل ۲: نمودارهای هدایت الکتریکی بر حسب انرژی برای حاصل جمع ورودیها و مقدار نقلی مربوط به جمع کننده کامل شامل هشت حلقه کوانتومی برای حالتی که ٥=٥, ٧٥=٥, ٧٥ تمامی ورودیها برابر صفر منطقی است.



V_a=0, V_b=0, V_c=2 (₅

شکل ۳. نمودارهای هدایت الکتریکی بر حسب انرژی برای حاصل جمع ورودیها و مقدار نقلی مربوط به جمع کننده کامل شامل هشت حلقه کوانتومی برای حالتی که یکی از ورودی ها برابر یک منطقی است



 $V_a=2, V_b=2, V_c=0$ (lie)







ب−V va=0, Vb=2, Vc=0

بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ | سال نهم







شکل ۵. نمودارهای هدایت الکتریکی بر حسب انرژی برای حاصل جمع ورودیها و مقدار نقلی مربوط به جمع کننده کامل شامل هشت حلقه کوانتومی برای حالتی که تمامی ورودی های سیستم برابر یک منطقی است. $V_a=2, V_b=2, V_c=2$

برای درک بهتر مفاهیم بالا، میتوان به بررسی نمودار جریان الکتریکی بر حسب اختلاف پتانسیل اعمال شده بین دو الکترود پرداخت. در رابطه (۹) جریان عبوری از حلقههای کوانتومی بر اساس انتگرال تابع انتقال بدست می آید و همچنین، تابع انتقال نيز طبق رابطه (۳) با معلوم بودن هدايت الكتريكي بدست مي آيد. شکل(۶) نمودارهای جریان الکتریکی بر حسب اختلاف پتسانیل برای حاصل جمع ورودیهای جمع کننده کامل و مقدار نقلی آن را نشان میدهد. در این حالت تمامی ورودی ها برابر صفر است و هیچ جریانی خروجی در سیستم وجود ندارد. مطابق شکل (۷)، اگر یکی از ورودیها برابر ۲ ولت باشد، تنها در بخش حاصل جمع جریان الکترونی وجود دارد و هنگامی که دو تا از ورودی ها برابر با ۲ ولت باشد (شکل (۸)) صرفا در بخش مقدار نقلی وجود جریان مشهود است. در واقع نتایج فوق مطابق با نمودارهای هدایت الکتریکی–انرژی است. زیرا جریان ناشی از انتقال االکترونی به دلیل وجود قلههای تشدید موجود در نمودار هدایت الكتريكي است. همچنين، افزايش ولتاژ باياس، پتانسيل الكترودها را افزایش میدهد و به موجب آن سطوح انرژی حلقههای



کوانتومی بیشتر میشود، در نتیجه موجب افزایش جریان و افزایش شیب صعودی منحنی آن میشود.



شکل ۶ نمودارهای جریان الکتریکی بر حسب اختلاف پتانسیل برای حاصل جمع ورودیها و مقدار نقلی مربوط به جمع کننده کامل شامل هشت حلقه کوانتومی برای حالتی که تمام ورودیهای سیستم برابر صفر منطقی است. V_a=0, V_b=0, V_c=0





V_a=0, V_b=0, V_c=2 (₹

شکل ۷. نمودارهای جریان الکتریکی بر حسب اختلاف پتانسیل برای حاصل جمع ورودیها و مقدار نقلی مربوط به جمع کننده کامل شامل هشت حلقه کوانتومی برای حالتی که که یکی از ورودیهای سیستم برابر یک منطقی است.



الف) Va=2, Vb=2, Vc=0 (الف





جریان-ولتاژ تشریح شده است. طبق نتایج هنگامی که حاصل جمع (Sum) در قسمت خروجی جمع کننده کامل برابر یک (منطقی) خواهد شد که همه ورودیها و یا یکی از ورودیها برابر یک باشد. همچنین، مقدار نقلی خروجی (Carry out) زمانی برابر یک منطقی می شود که همه ورودی ها و یا دو تا از ورودی ها برابر یک باشند. به طور واضح مشخص است که سیستم فوق مطابق با مشخصه جمع کننده کامل دودویی عمل می کند.

 ۲): جدول درستی جمع کننده کامل براساس ورودی ها و خروجیهای 	جدول (،
جدول درستی جمع کننده کامل براساس ورودی ها و حروجیهای سیستم در ولتاژ بایاس ۶ ولت	

V _c (V)	V _b (V)	V _a (V)	I _(sum) (A)	I _(carry out) (A)
0	0	0	0	0
0	0	2	0.367	0
0	2	0	0.817	0
0	2	2	0	0.174
2	0	0	0.728	0
2	0	2	0	0.378
2	2	0	0	0.643
2	2	2	0.215	0.919

مراجع

[1] A. Aviram, M. A., Ratner, Molecular Rectifiers. Chemical physics letters, 29(2), 277, 1974.

[2] V. Alba, "Entanglement and quantum transport in integrable systems", Physical Review B, 97(24), 245135, (2018).

[3] M. Thoss, & F. Evers, "Perspective: Theory of quantum transport in molecular junctions". The Journal of chemical physics, 148(3), 030901, 2018.

[4] A. Shedbalkar, & B. Witzigmann,"Non equilibrium Green's function quantum transport for green multi-quantum well nitride light emitting



شکل ۹ نمودارهای جریان الکتریکی بر حسب اختلاف پتانسیل برای حاصل جمع ورودیها و مقدار نقلی مربوط به جمع کننده کامل شامل هشت حلقه کوانتومی برای حالتی که تمامی ورودیهای سیستم برابر یک منطقی است. V_a=2, V_b=2, V_c=2

جدول(۱)، جریان های خروجی را براساس ولتاژهای ورودی سیستم نشان میدهد. دامنه جریانها در ولتاژ بایاس ۶ ولت محاسبه شد. همانطور که مشخص است نتایج به دست آمده مطابق با جدول درستی یک جمع کننده کامل شکل گرفته است. واحد اندازه گیری جریانهای خروجی بر اساس آمپر است.

۴– نتیجهگیری

در این مقاله مدار یک جمع کننده کامل دودویی با استفاده از هشت حلقه کوانتومی طراحی و شبیه سازی شده است که هر حلقه تحت تاثیر شار مغناطیسی ($2/_0 \varphi = \varphi$) قرار دارد. حلقه-های کوانتومی به دو گروه چهارتایی تقسیم شدهاند که به صورت موازی به یکدیگر متصل شدهاند و به صورت متقارن به دو الکترود (چشمه-درآشامنده) متصل میشوند. همچنین ولتاژ های الکترود (چشمه-درآشامنده) متصل میشوند. همچنین ولتاژ های مدل سازی سیستم براساس مدل بستگی قوی انجام گرفته و محاسبات عددی با استفاده از روش تابع گرین انجام شده است. نتایج بدست آمده براساس نمودارهای هدایت الکتریکی-انرژی و

[13] S. K.Maiti, "Quantum transport in a mesoscopic ring: Evidence of an OR gate", Solid State Communications, 149(39 - 40), 1684-1688, 2009.

[14] S. K.Maiti, "XOR gate response in a mesoscopic ring with embedded quantum dots". Solid State Communications, 149(39-40), 1623-1627, 2009.

[15] S. K.Maiti, "A Mesoscopic Ring as a XNOR Gate: An Exact Result", Journal of the Physical Society of Japan, 78(11), 114602, 2009.

[16] S. K.Maiti, "NAND gate response in a mesoscopic ring: an exact result" Physica Scripta, 80(5), 2009.

[17] S. K.Maiti, "A Mesoscopic Ring as a NOT Gate: An Exact Result" Computational and Theoretical Nanoscience, 7(6), 594-599, 2009.

[18] H. Khanzadi., H. K. Salehani., "Design of Basic Logic Gates by Triple Quantum Rings. Nanoscience and Technology", 2(2), 119-121, 2016.

[19]. L.F. AL-Badry," The electronic properties of concentric double quantum ring and possibility designing XOR gate", Solid State Communications, 254, 15-20, 2017.

[20]. L. Eslami, M. Esmaeilzadeh, "Spinpolarization and spin-dependent logic gates in a double quantum ring based on Rashba spin-orbit effect: Non-equilibrium Green's function approach.", Journal of Applied Physics, 115, 084307, 2014.

[21]. E. Dehghan, D. Sanavi Khoshnoudy, A.S. Naeimi, "NAND/AND/NOT logic gates response

diodes", Optical and Quantum Electronics, 50(2), 67, 2018.

[5]. N. Ho & C. Emary, "Counting statistics of dark-state transport through a carbon nanotube quantum dot", Physical Review B, 100(24), 245414, 2019.

[6] H. Zhang, D. E. Liu, M. Wimmer, & L. P. Kouwenhoven, "Next steps of quantum transport in Majorana nanowire devices", Nature communications, 10, 1-7, 2019.

[7] M. A. Darehdor, M. R. Roknabadi, & N. Shahtahmassebi, "Effects of phonon scattering on the electron transport and photocurrent of graphene quantum dot structures", The European Physical Journal B, 92(1), 1-8, 2019.

[8]. A. Donarini, M. Niklas, M. Schafberger, P. Nicola, S. Christoph, G. Milena, "Coherent population trapping by dark state formation in a carbon nanotube quantum dot"., Nature communications, 10, 381, 2019.

[9]. Y. Aharonov, D. Bohm, "Significance of electromagnetic potentials in quantum theory", Physical Review, 115, 485-491, 1995.

[10]. M. Büttiker, Y. Imry, R. Landauer, "Josephson behavior in small normal onedimensional rings", Physics Letters A, 96, 365-367, 1983.

[11] S. K.Maiti, "Electron transport in a double quantum ring: Evidence of an AND gate", Physics Letters A, 373, 4470-4474, 2009.

[12] S. K.Maiti, "NOR gate response in a double quantum ring: An exact result" Solid State Communications, 149(47-48), 2146-2150, 2009.

in series of mesoscopic quantum rings", Modern Physics Letters B, 33(34), 1950431, 2019.

[22]. D. Cricchio, E., Fiordilino, "Quantum Ring in a Magnetic Field: High Harmonic Generation and NOT Logic Gate" Advanced Theory and Simulations., 3(7), 2000070, 2020.

[23] M. M. Mano, & M. D. Ciletti, "Digital Design: with an introduction to the Verilog HDL", New Jersey : Pearson Education., 2013.

[24]. S. Datta, Quantum Transport, Atom to Transistor, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

[25]. O. Hod, R. Baer, E. Rabani, "Feasible Nanometric Magnetoresistance Devices" The journal of physical chemistry. B, 108, 14807-14810, 2004.

[26]. O. Hod, R. Baer, E. Rabani,
"Magnetoresistance of nanoscale molecular devices based on Aharonov-Bohm interferometry",
Journal of Physics Condensed Matter, 20, 383201, 2008.

[27]. O. Hod, R. Baer, E. Rabani, "Magnetoresistance devices based on single-walled carbon nanotubes", Journal of the American Chemical Society, 127, 1648-1649, 2005.

[28]. O. Hod, R. Baer, E. Rabani, "Magnetoresistance of nanoscale molecular devices" Accounts of Chemical Research.. 39, 109-117, 2006.



Design and simulation of a binary full adder based

on quantum rings

A.Taghavi Motlagh, H. Khajeh salehani*

Department of Electrical Engineering, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.

Abstract: In this paper, a binary full adder circuit is designed with eight quantum rings where each ring is threaded by a magnetic flux $\varphi_0/2$. The quantum rings are divided into two categories with four rings connected to each other in parallel. They are attached symmetrically to two semi-infinite one-dimensional metallic electrodes, and three gate voltages are applied as three inputs of the full adder. The Hamiltonian of system is approximated by the tight binding method, and the calculations are performed by using Green's function formalism. The conductance-energy and current-voltage characteristics are obtained for different values of applied gate voltage. The results show this quantum circuit behaves as a binary full adder.

Keywords: Quantum Transport, Quantum ring, Full adder, Green Function